

Настройка и диагностика на микропроцесорни системи



Автор: гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

Съдържание

1. Видове постоянна памет
2. Микропроцесорни и ROM емулатори
3. Интерфейс JTAG
4. Интерфейс SWD

Видове постоянна памет

В зависимост от предназначението, паметите в една микропроцесорна система може да се разделят на два вида:

- *памет за данни
- *памет за инструкции

Видове постоянна памет

Памет за данни – енергозависима памет /съдържанието ѝ се губи при премахване на захранването/, в която се съхраняват временни резултати от изчисления в хода на изпълнението на програмата. Технологията, която се използва най-често за този вид памет е RAM.

Памет за инструкции (програмна памет) – енергонезависима памет /съдържанието ѝ се запазва дори при премахнато захранване/, в която се съхранява програмата на системата. Част от тази памет може да се зареди в RAM, за да се подобри производителността на системата, но името на този сегмент си остава “програмна памет”. Използваната технология е ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash и Ferroelectric.

Видове постоянна памет

ROM (Read Only Memory) – енергонезависима памет, която се “програмира” по време на производството на чипа.

*Тя не може да бъде изтривана или записвана наново.

*Среща се и понятието Mask ROM.

Стойностите на битовете се реализират по различни начини:

*чрез метални контакти (връзка към V_{dd} означава 1, връзка към V_{ss} означава 0);

*различни видове MOS транзистори (с индуциран или вграден канал)

*MOS транзистори с тънък или дебел оксиден слой на гейта (тънък – ниско прагово напрежение V_{GS} , дебел – високо прагово напрежение V_{GS}).

Видове постоянна памет

PROM (Programmable Read Only Memory) – енергонезависима памет, която се програмира от потребителя чрез електричество.

*Програмирането се състои в прегаряне на “бушони”, играещи ролята на битове. Алтернативното логическо състояние се представя със здрав, непрегорен бушон.

*Бушоните се реализират с полупроводникови елементи (диоды, транзистори, и т.н.). Прилагат се високи импулсни напрежения, които превръщат полупроводника в проводник.

*Веднъж записани, съдържанието им не може да се променя.

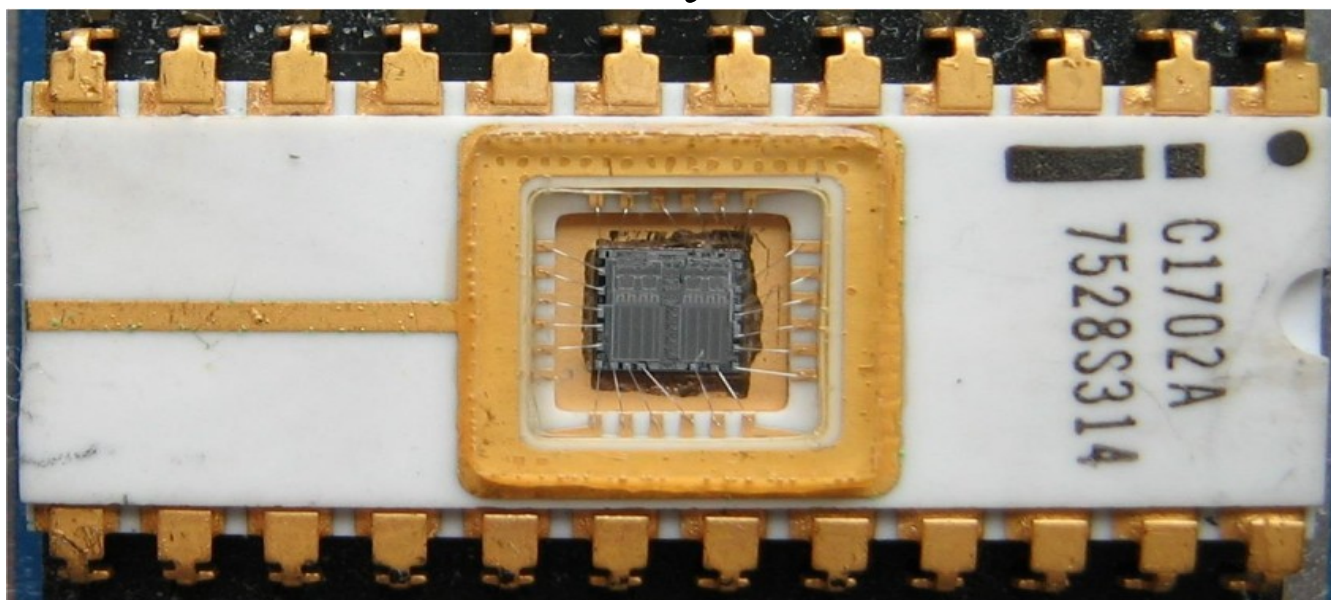
*Среща се и понятието **One Time Programmable, OTP**.

Видове постоянна памет

EPROM (UV Erasable Programmable Read Only Memory) – енергонезависима памет, която се записва от потребителя чрез електричество и се трие чрез UV светлина.

*Корпусите на тези чипове имат кварцови прозорчета, позволяващи UV светлината да достигне кристала на чипа и да изтрие битовете.

*Триенето отнема $20 \div 40$ минути.

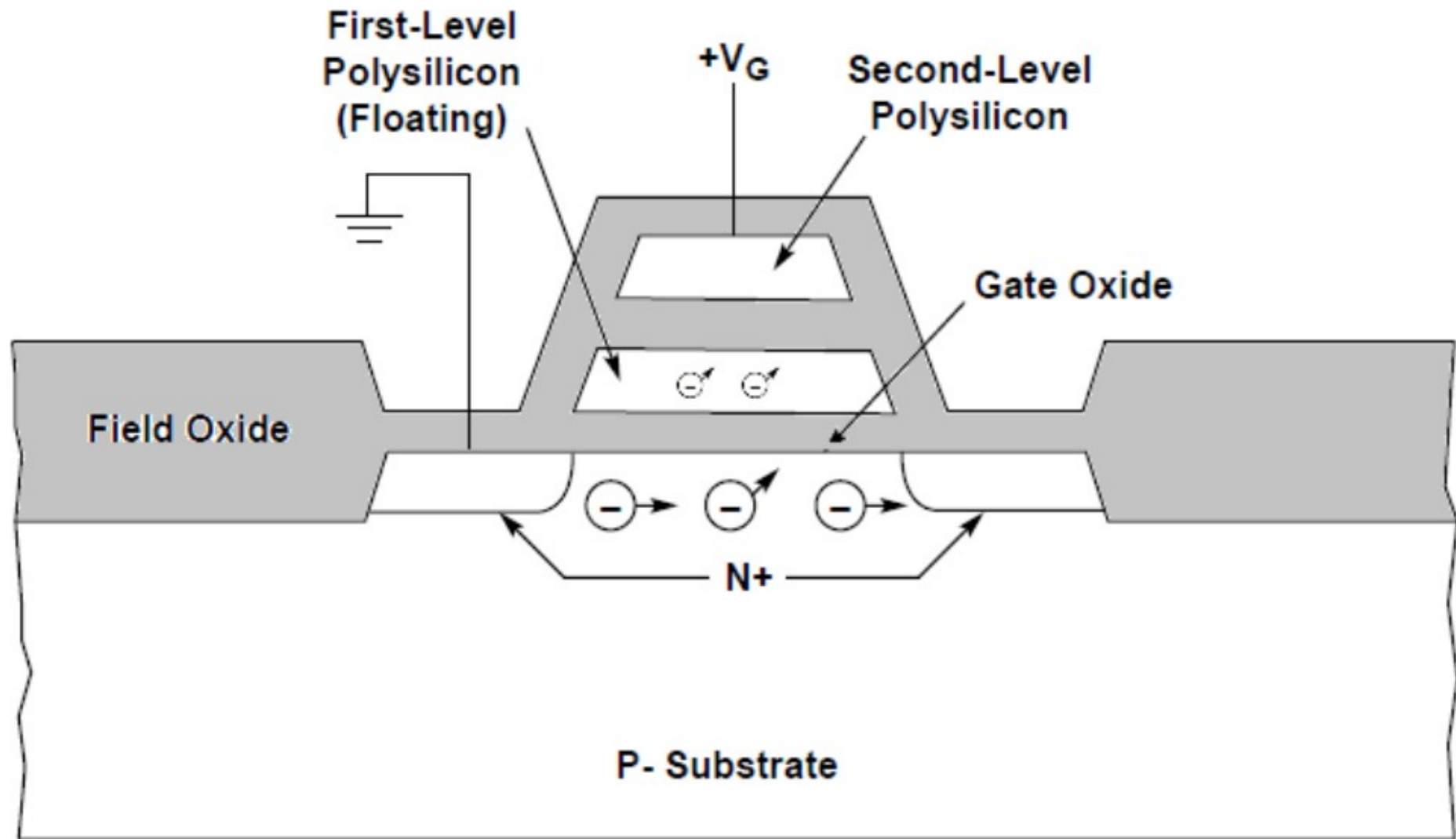


Видове постоянна памет

EPROM съхранява информацията чрез електрически заряд, заключен в т.нар. плаващ гейт. Плаващ гейт е полисилициев материал заровен в диелектрика между гейта и канала на MOS транзистор.

Когато се подаде напрежение между гейта и дрейна, електрони с голяма енергия се пренасят към и остават в плаващия гейт. Това води до промяна на праговото напрежение на транзистора, което всъщност се води запамятване на 0 или 1.

Видове постійна пам'ят



Source: Intel/ICE, "Memory 1997"

18474

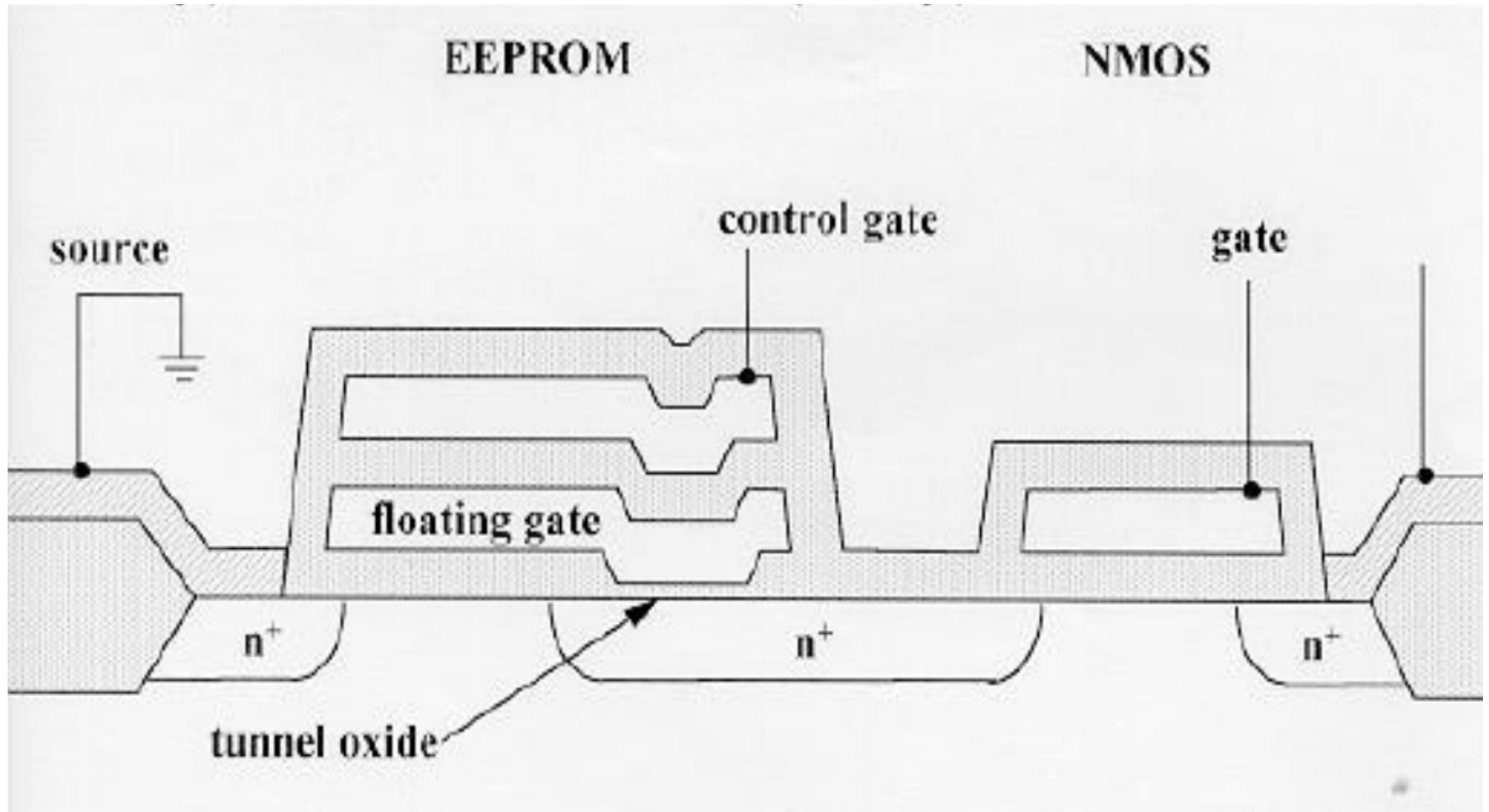
Figure 9-4. Double-Poly Structure (EPROM/Flash Memory Cell)

Видове постоянна памет

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) – енергонезависима памет, която се записва и трие от потребителя чрез електричество.

Вътрешната структура е аналогична на EPROM с една съществена разлика – изолацията на дрейна се прави по-тънка. Това позволява запаметените електрони (заряд) да бъдат разсеяни обратно в дрейна при триене на чипа.

Видове постоянна памет



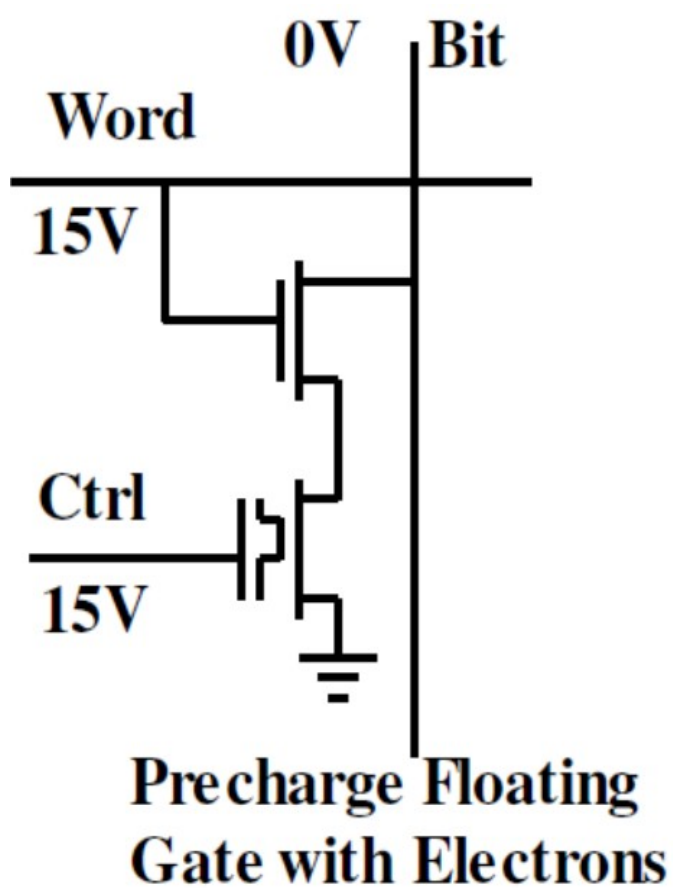
Видове постоянна памет

Триенето се извършва чрез подаване на високо напрежение на дрейна, докато гейта се задържа в 0 V. (Допълнителният транзистор за програмиране се нарича “select” транзистор).

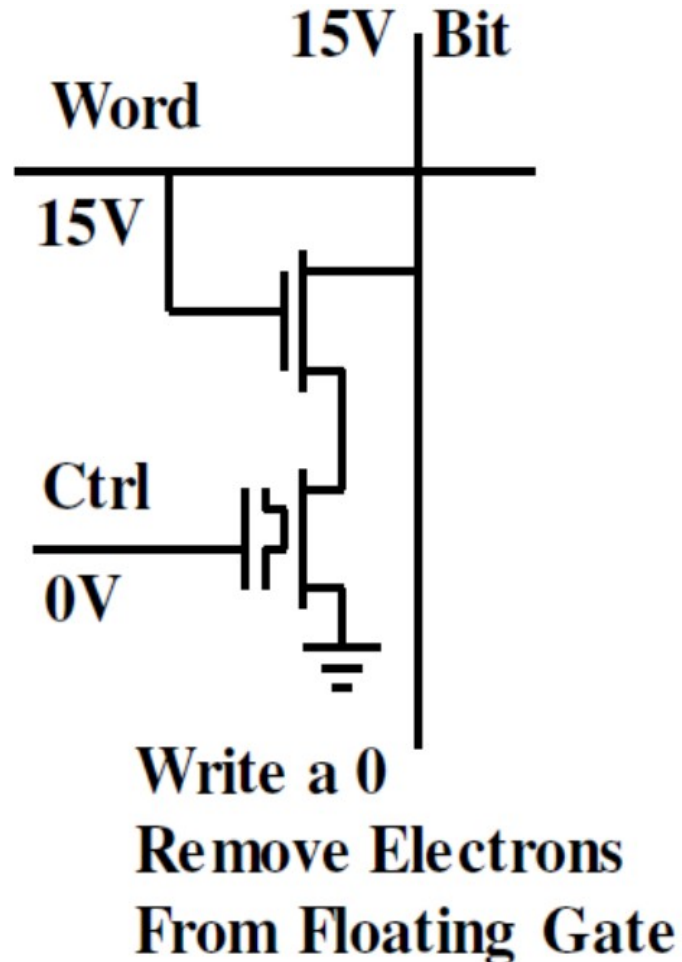
*Обикновено един select-MOS се свързва с други 8 транзистора с плаващ гейт, което позволява триене на ниво **1 байт**.

*Циклите запис/презапис в тези паметни са в обхвата 100 000 ÷ 1 000 000.

Видове постоянна памет

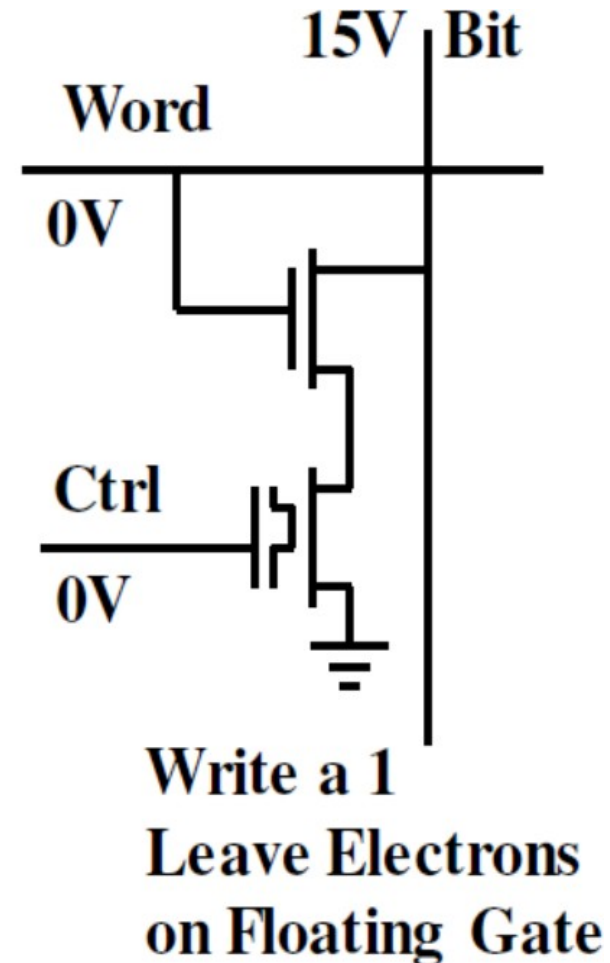


Първо всички клетки се записват с 1-ци.



Ако битът трябва да е 0:

$$V_{GS}=0, V_D=V_{HIGH}$$



Ако битът трябва да е 1: $V_{GS}=0, V_D=0$.

Видове постоянна памет

Flash - енергонезависима памет, която се записва и трие от потребителя чрез електричество.

Недостатъци - използва **същата технология като EEPROM**, но някои от параметрите ѝ са влошени:

*Схемотехниката позволява да се трият само цели **блокове** или **сектори** (а не байт-по-байт като при EEPROM).

*Циклите запис/триене са в обхвата $1000 \div 100\,000$.

Предимства – въпреки, че записа/триенето не може да стане байт по байт, работата с блокове и сектори води до повишаване на бързодействието спрямо EEPROM-а.

Видове постоянна памет

В зависимост от използваната схемотехника, Flash паметите се разделят на два вида:

***NOR flash** – клетките (транзисторите) с плаващ гейт са свързани към адресната шина в паралел, което позволява достъп до отделни байтове (като при EEPROM).

***NAND flash** - клетките (транзисторите) с плаващ гейт се свързват към адресната шина последователно, което позволява достъп на блокове и сектори.

Видове постоянна памет

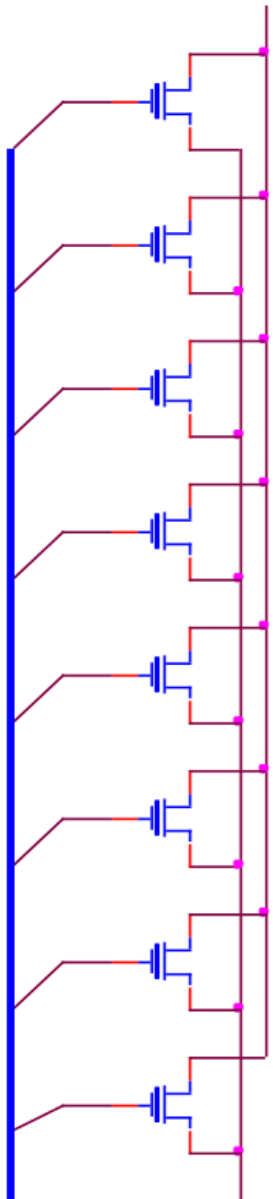
***NOR flash** са подходящи за контролни приложения (control) – заемат повече площ на кристала (имат повече метални контакти, [1]) и по-бавно се записват/трият. От друга страна, те се четат по-бързо, т.е. може да се използват като програмна памет.

***NAND flash** са подходящи за съхранение на големи обеми от данни (storage), защото заемат малко място на кристала. Записват се и се трият по-бързо от NOR, но се четат по-бавно от NOR.

Вилкове постоянна памет

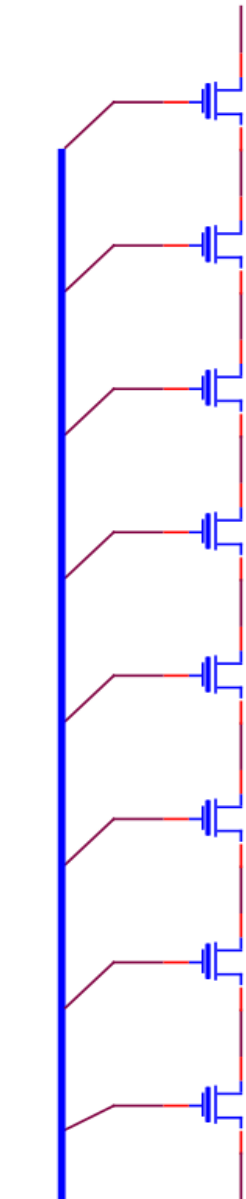
NOR

Bit line



NAND

Bit line



ВНИМАНИЕ!

Байтовете са
разположени
хоризонтално, т.е.
схемата показва само по
1 бит от 8 байта
разположени един върху
друг.

Видове постоянна памет

За да се прочете даден бит в NAND се използва следния **аналогов** метод:

- *подава се логическа 1 на сигнала Bit line;
- *към транзисторът, който ще се чете, се подава напрежение близко до праговото на гейта;
- *на гейтовете на всички останали битове от колоната се подават по-високи напрежения, за да се отпушат на 100% без значение дали е записана 0 или 1 в тях;
- *ако в гейта има заряд, праговото му напрежение ще се е повишило и транзисторът няма да се отпуши. На Source line = 0V
- *ако в гейта няма заряд, праговото му напрежение ще е ниско и транзисторът ще се отпуши. На Source line = Bit line - V_{GStH}

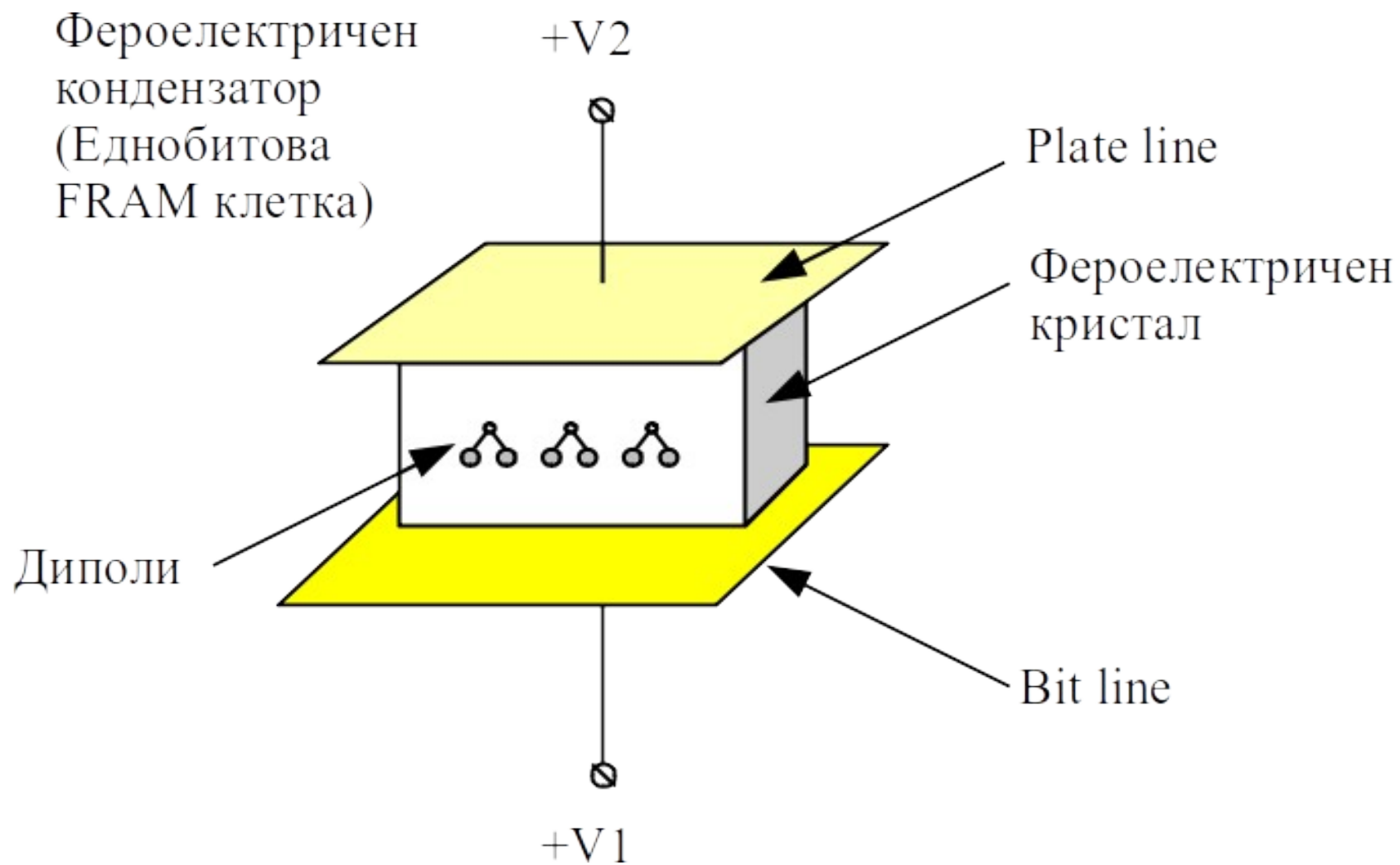
Видове постоянна памет

FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) - енергонезависима памет, която се записва и трие от потребителя чрез електричество.

Използва се за **програмна памет**, НО поради големия брой цикли запис/триене, които може да издържи, възможно е приложението ѝ също като **даннова памет** (затова се добавя съкращението RAM).

Информацията се запамятава в керамичен материал, който проявява свойства, подобни на феритните материали.

Видове постоянна памет



Видове постоянна памет

При прилагане на напрежение на електродите V1 и V2, диполите (молекулите) на фероелектричния кондензатор променят ориентацията си.

Сравнителна таблица на Texas Instruments [2]:

Comparison of Memory Attributes

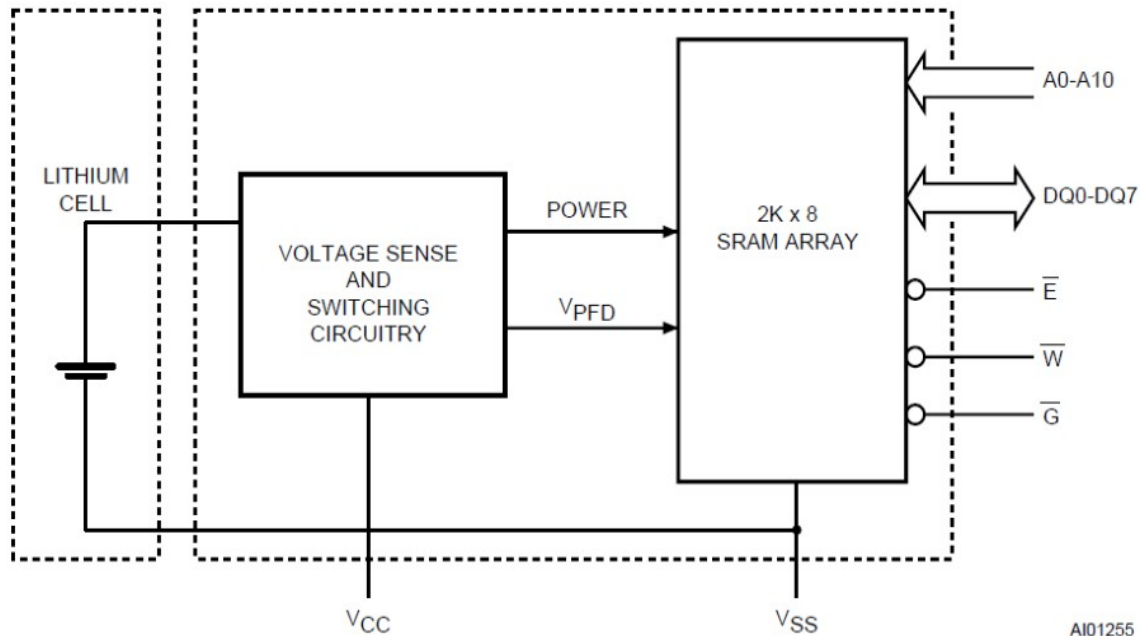
	FRAM	EEPROM	Flash
Time to write 64 bytes to memory	1.6 μs	2,200 μs	6,400 μs
Time to read 64 bytes from memory	1.6 μs	4.5 μs	4.5 μs
Number of write cycles	100 trillion	500,000	100,000
Voltage needed to write	1.5 V	10 to 14 V	10 to 14 V
Manufacturing cycle time	–	>3×	3×
Resistance to gamma radiation	Yes	No	No

Видове постоянна памет

Батерийно-подсигурана RAM (Battery-backed RAM) - енергонезависима памет, която се записва и трие от потребителя чрез електричество [3].

- *Това е SRAM с интегрирана батерия в корпуса на чипа
- *Ако батерията се изтощи, чипът трябва да се смени
- *Среща се още като NVRAM (**Non-Volatile RAM**) или ZRAM (**Zeropower RAM**)
- *Има неограничен брой цикли запис/триене
- *Кратки времена за четене/запис

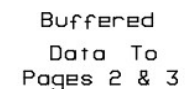
Видове постоянна памет



AI01255



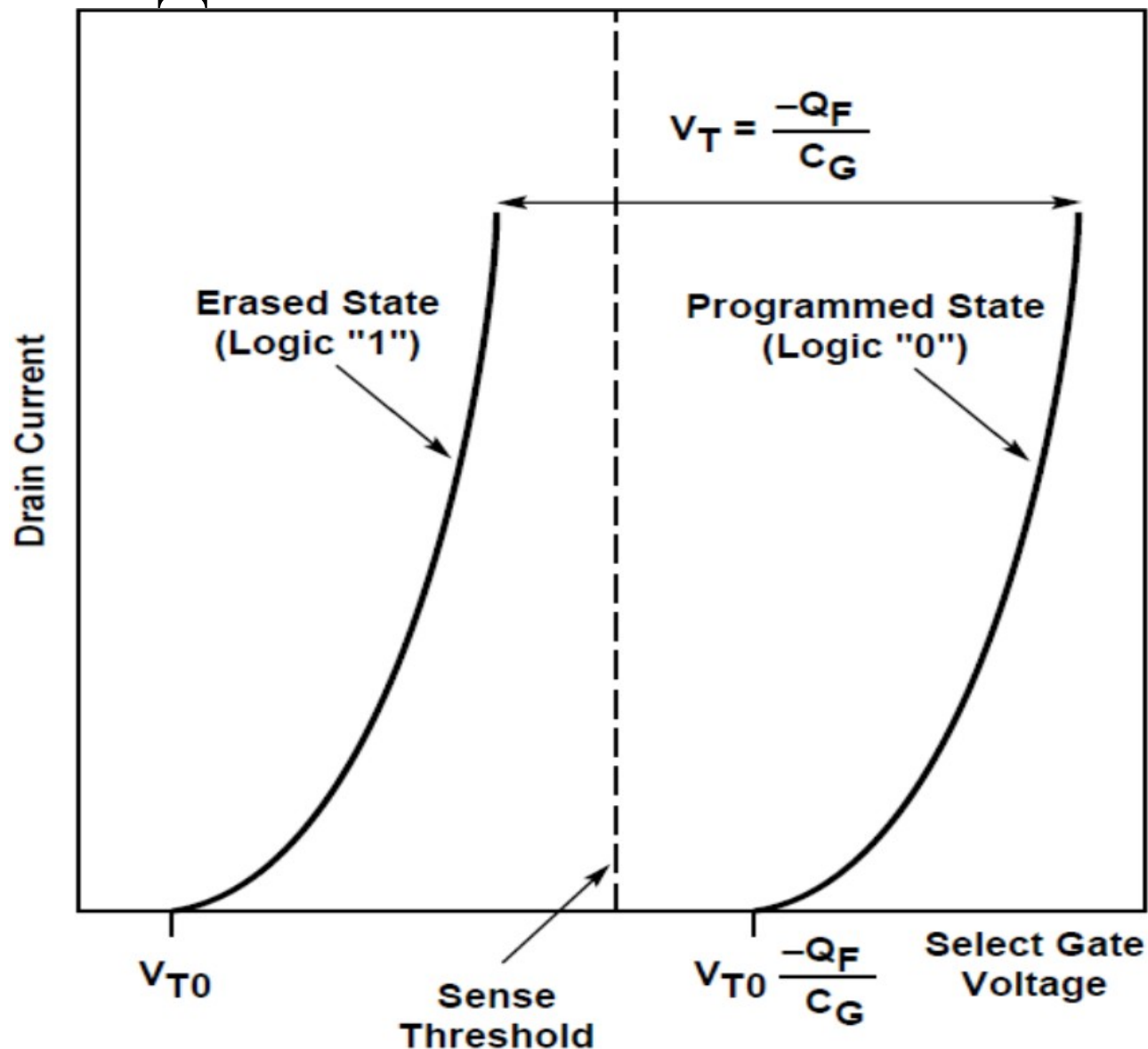
Пример – машината за катодно разпрасване Emitech K550x използва ZRAM 48Z02 за /най-вероятно/ съхраняване потребителските настройки на уреда.



Видове постоянна памет

Обобщение – паметите с плаващ гейт, показани на миналите слайдове, използват праговото напрежение на гейт-сорс на транзистор, за да запамятят един бит информация. Това означава, че в зависимост от това дали има записана 1 или 0, транзисторът **няма да провежда** или **ще провежда** при подаване на едно и също напрежение на електродите гейт и сорс.

Видове постоянна памет



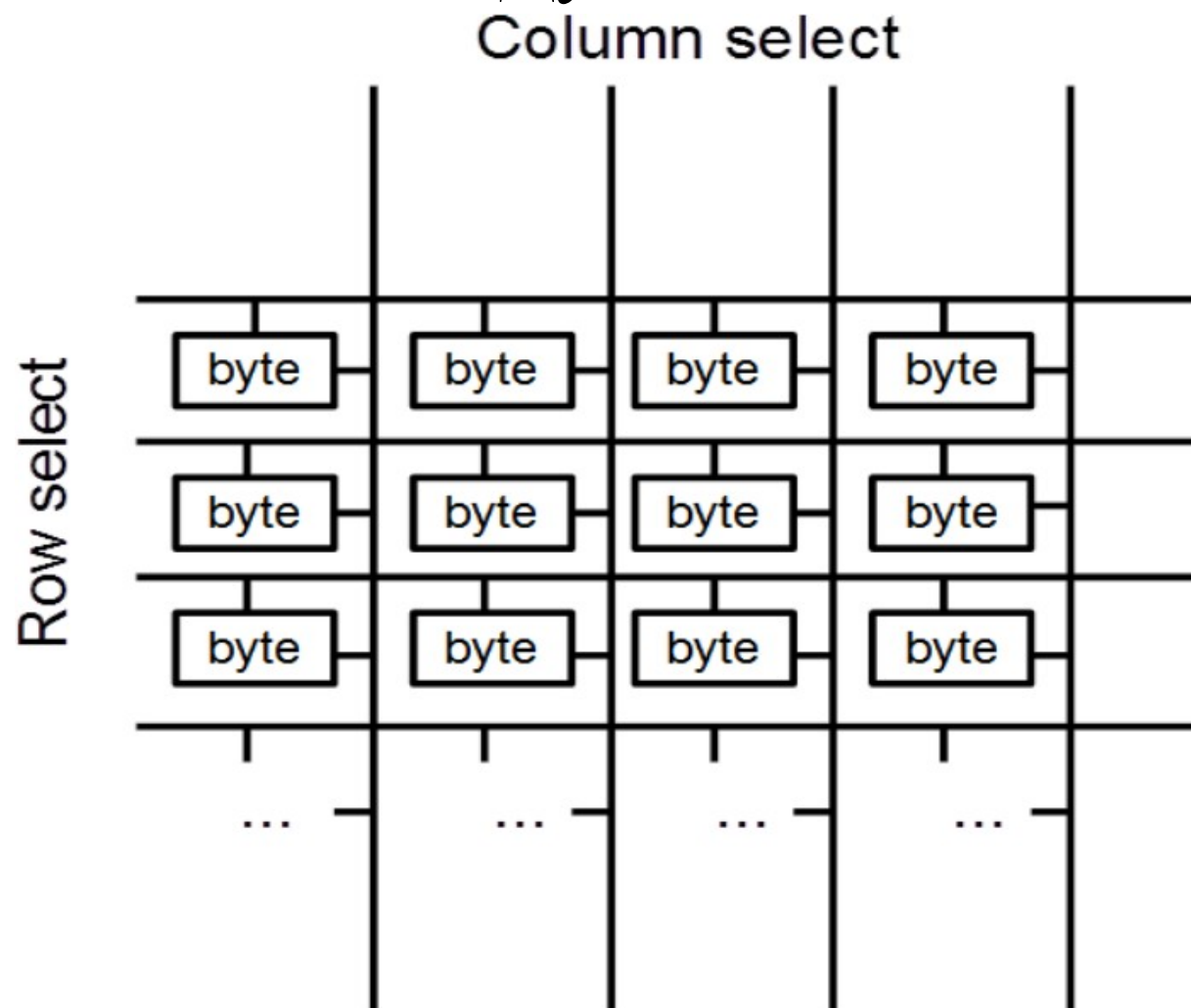
Source: ICE, "Memory 1997"

17548A

Figure 9-6. Electrical Characteristics of an EPROM

Видове постоянна памет

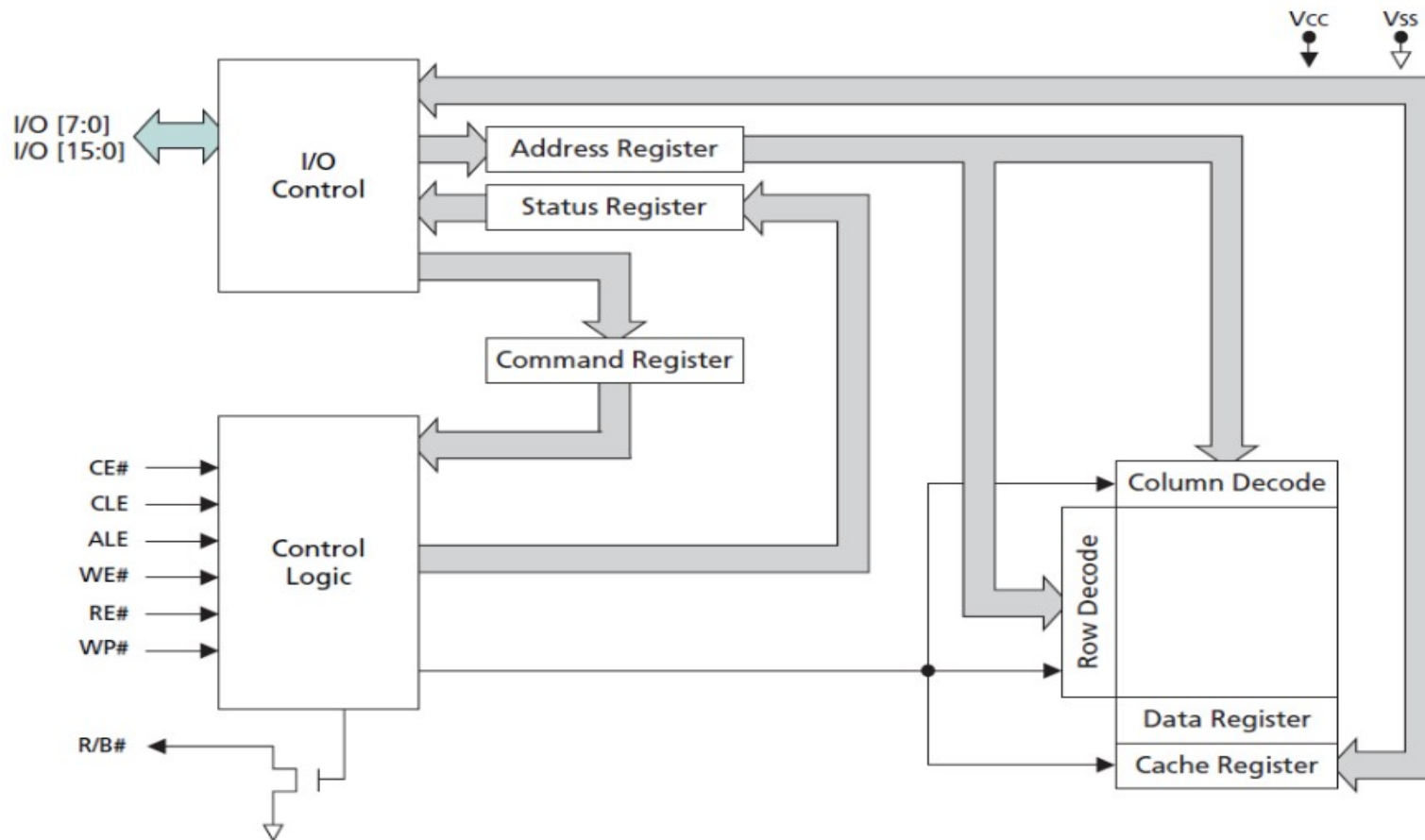
Битовете от паметите се групират в думи, които са свързани в матрица и са адресируеми по колона и ред, както при SRAM и DRAM. Думите може да са по-големи от 1 байт.



Видове постоянна памет

Пример – вътрешна структура на 8 GB NAND Flash чип. Обърнете внимание на декодерите за ред и колона.

NAND Flash Functional Block Diagram



Note: The PRE function is not supported on extended-temperature devices.

Видове постоянна памет

Триенето, записа и четенето на вградени в μ CU и външни енергонезависими памети става посредством уред, който се нарича **програматор**.

Чипът, който ще се програмира се поставя в цокъл с изводи повече или равни на чипа, който ще се програмира. Ако изводите на цокъла са повече, чипът трябва да се постави на **точно определено място**. Често се използва ZIF (Zero Insertion Force) цокъл.

Програматорът се свързва към персонален компютър, който използва специализиран софтуер за програмиране на памети и микроконтролери.

Микропроцесорни и ROM емулатори

ROM емулатор (ROM emulator) – уред, който се включва на мястото на външна ROM памет от вградената система и **наподобява поведението на паметта** (=емулира) по такъв начин, че μ PU все едно използва оригиналната памет.

ROM емулатора се свързва към персонален компютър посредством стандартен интерфейс (напр. RS232, паралелен порт, и т.н.).

ROM емулатора има **сонда**, която се свързва към цокъла на емулираната памет.

Микропроцесорни и ROM емулатори

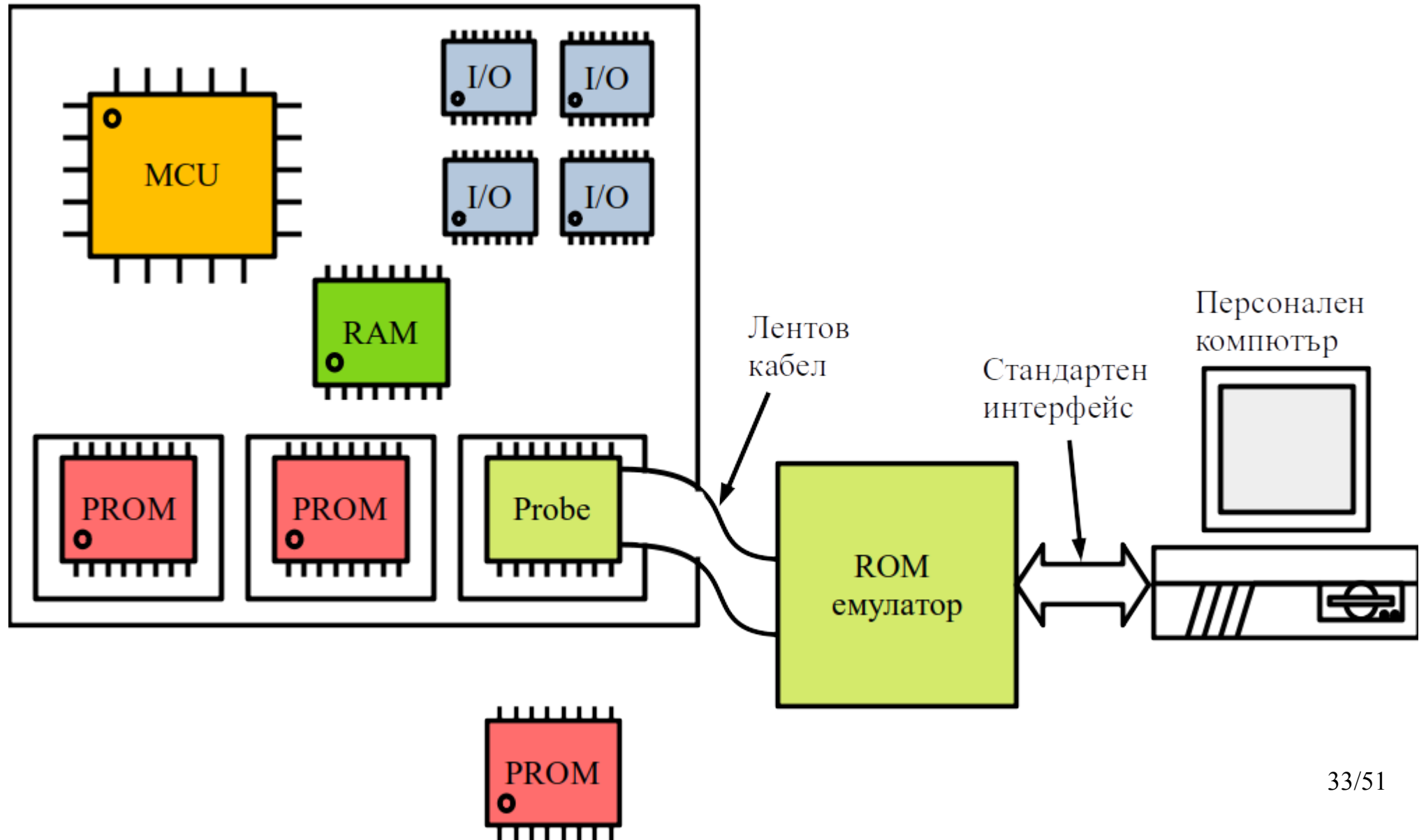
На персоналният компютър върви специално приложение, което прехвърля потребителския фърмуер в ROM емулатора (най-често се използва ZRAM).

С помощта на ROM емулатор времето за развой се намалява значително (особено ако се емулира UV EPROM).

ROM емулаторите вече са история (ROM паметите са вградени в микроконтролери, работят с високи тактови честоти).

Микропроцесорни и ROM емулатори

Разработвана вградена система



Микропроцесорни и ROM емулатори

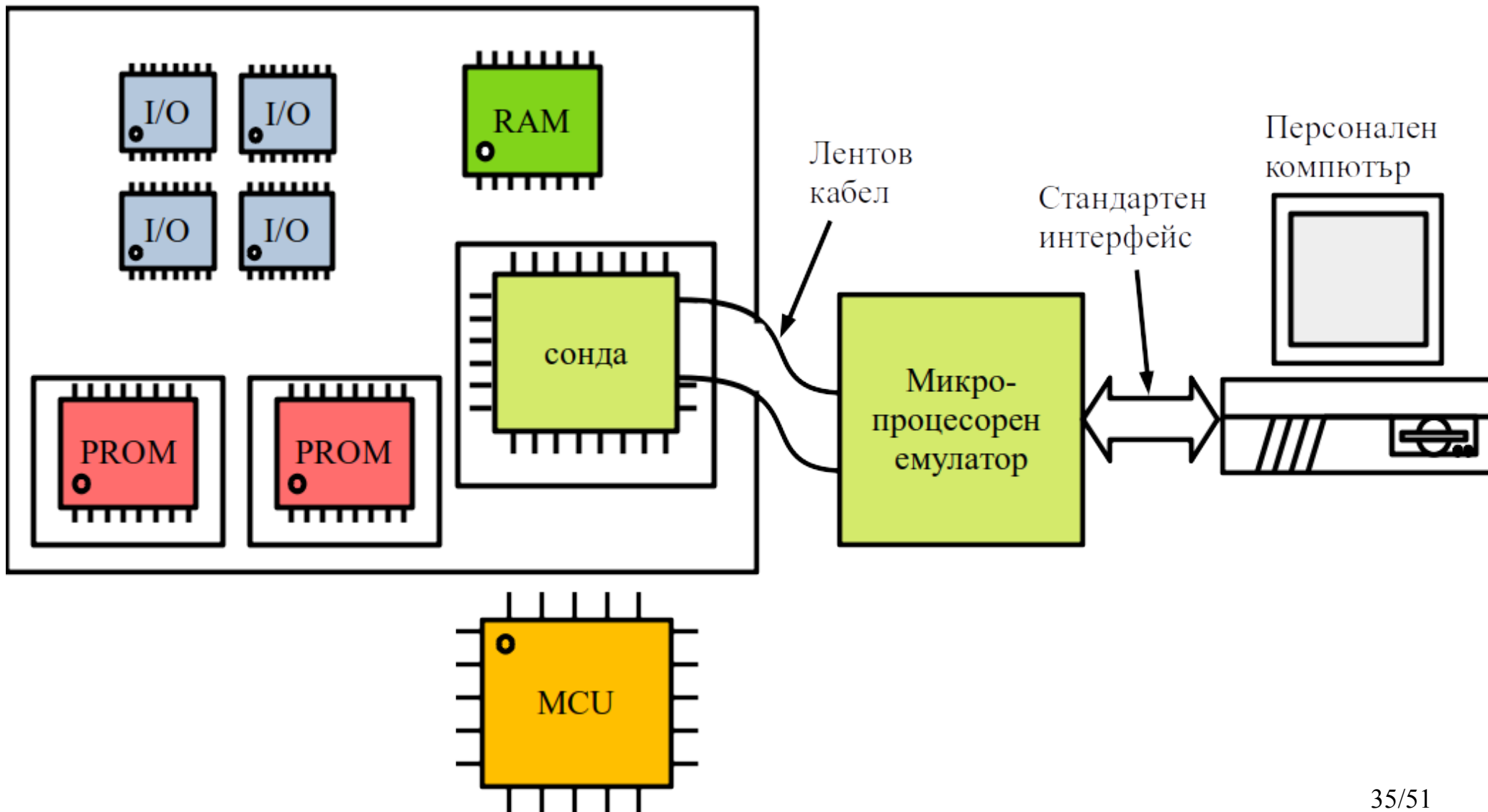
Микропроцесорен емулатор (microprocessor emulator) - уред, който се включва на мястото на микропроцесора от вградената система (когато той е на отделен чип) и **наподобява поведението на микропроцесора** (=емулира) по такъв начин, че останалата част от системата (периферия и памети) все едно използва оригинала.

С помощта на μ PU емулаторите може да се открие дефектирал микропроцесор.

μ PU емулатори вече са история (микропроцесорите са вградени в микроконтролери, работят с високи тактови честоти).

Микропроцесорни и ROM емулатори

Разработвана вградена система



Микропроцесорни и ROM емулатори

ROM емулаторите и програматорите използват специализиран софтуер, за да прехвърлят потребителския фърмуер във вградената система.

Повечето такива приложения използват следните **файлови формати на фърмуера:**

- *.bin (двоичен файл)
- *.axf (двоичен файл с дебъгерна информация)
- *.elf (двоичен файл с дебъгерна информация)
- *.coff (двоичен файл с дебъгерна информация)
- *.ihex (Intel hex, текстови файл с ASCII символи)
- *.srec (Motorola hex, текстови файл с ASCII символи)
- *други

Микропроцесорни и ROM емулатори

Пример – съдържанието на ihex файл е показано по-долу.

```
:03000000020006F5
:03005F0002000399
:0300030002006296
:20006200AFA8747F5FF5A812018512018412017612017A43A8804398109000027433F0E490
:20008200A3F0A3F0A3F0900002E0FCA3E0FDA3E0FEA3E0FF900001ECF0438010900002E4FE
:2000A200F0A3F0A3F0A3F0900002E0FCA3E0FDA3E0FEA3E0FFC3EC9488ED9413EE9400EFD4
:2000C20094005018900002E02401F0A3E03400F0A3E03400F0A3E03400F080CBAF8074EFC9
:2000E2005FF580900002E4F0A3F0A3F0A3F0900002E0FCA3E0FDA3E0FEA3E0FFC3EC94884F
:20010200ED9413EE9400EF94005018900002E02401F0A3E03400F0A3E03400F0A3E0340050
:20012200F080CB900002E02401F0A3E03400F0A3E03400F0A3E03400F0900001E0FF3395CE
:16014200E0FE8F828E83120158AE82AF83900001EEF002009B22AC
:20015800AF83E582900006F0EFA3F0900006E0FEA3E0FF740A2EFEE43F8E82F5832275867E
:200178000122902F11E4F0902F12F02222439810902F00E4F0902F08F0902F50F0AF8074C4
:05019800EF5FF580227D
:06003500E478FFF6D8FD9F
:200013007900E94400601B7A009001A1780875A000E493F2A308B8000205A0D9F4DAF275EA
:02003300A0FF2C
:20003B007800E84400600A790175A000E4F309D8FC7807E84400600C7901900001E4F0A3BB
:04005B00D8FCD9FAFA
:0D00060075811F12019DE582600302000359
:04019D007582002245
:00000001FF
```

Микропроцесорни и ROM емулатори

Форматът на всеки ред е:

:ссaaaarrddss

: - всеки ред започва с двуеточие

сс – брой байтове на реда

aaaa – адресът на първия байт от реда

rr – вид данни на реда (ако е 00 – потребителски байтове, ако е 01 – край на файла)

dd – потребителски байтове на инструкции/данни, може да са 0 ÷ 255 броя

ss – контролна сума на предшестващите байтове:

$$сс + aa_H + aa_L + rr + SUM(dd) + ss$$

Интерфейс JTAG

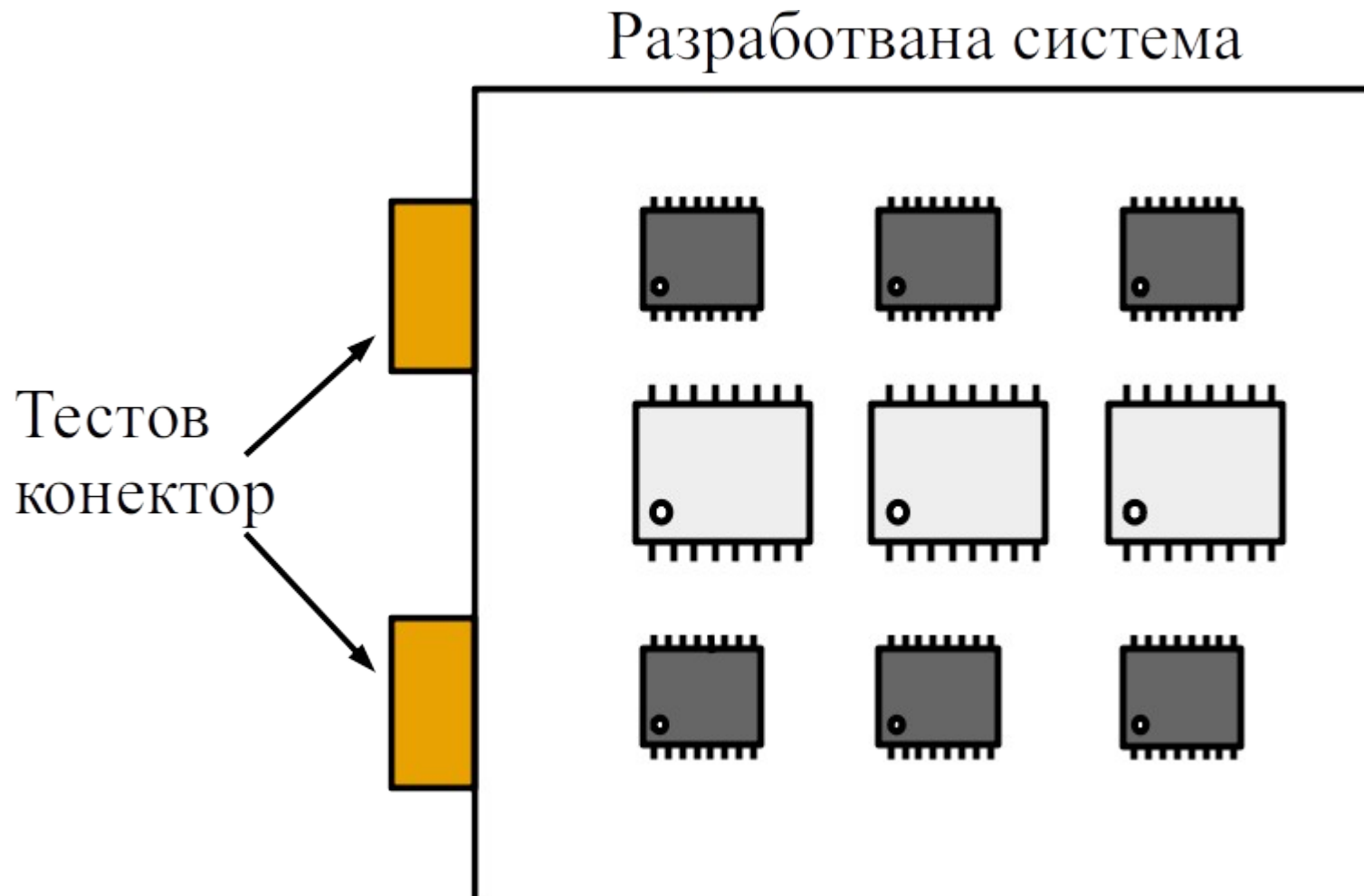
Печатните платки (Printed Circuit Board, PCB) на електронни уреди трябва да се тестват веднага щом слязат от производствената линия.

В миналото PCB са били прости, и съответно — процедурите за тест са били също прости.

За целите на тестването, инженерите вграждали тестови конектори на PCB.

На конекторите се извеждали сигнали от важни възли на схемата.

Интерфейс JTAG



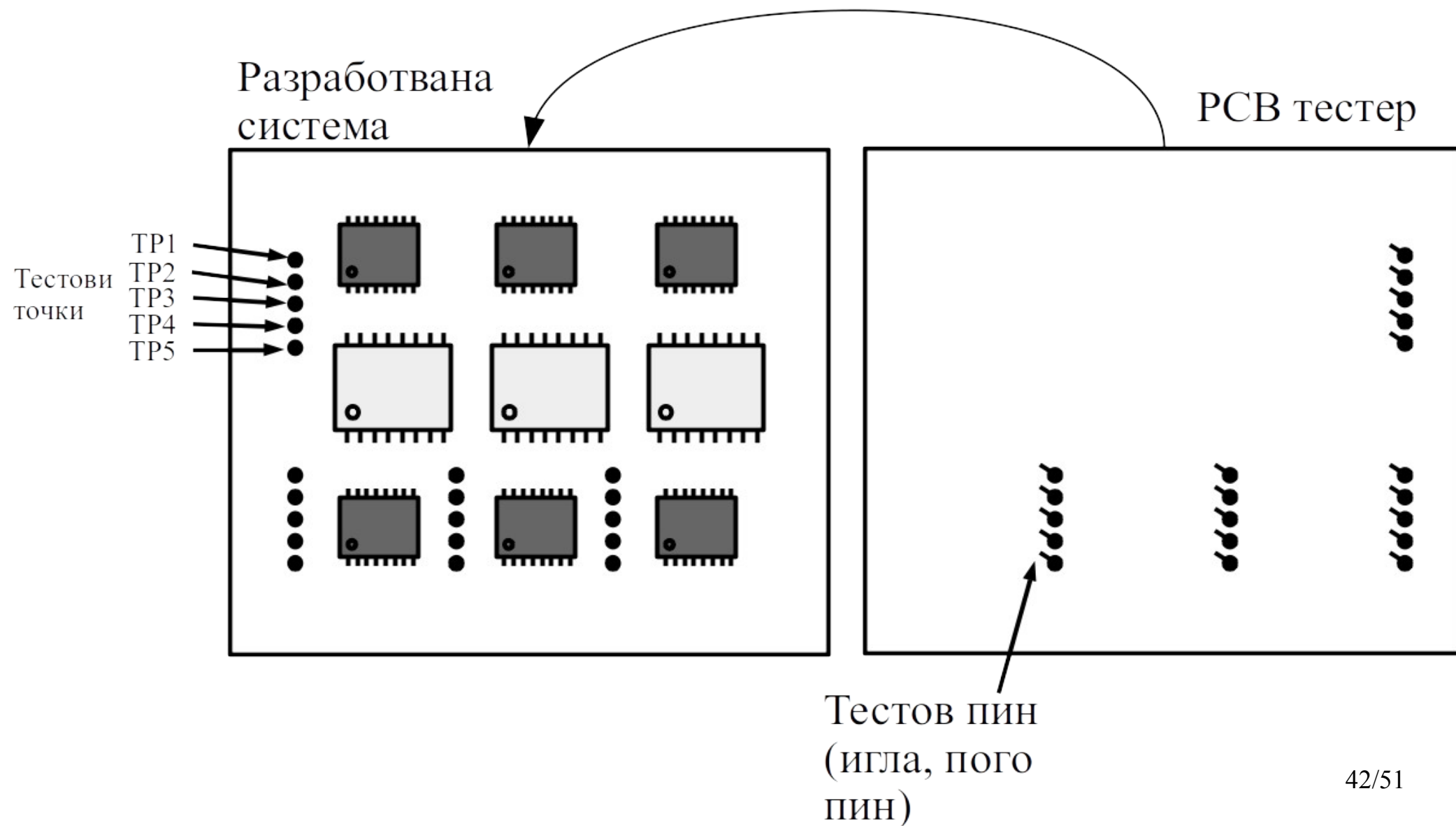
Интерфейс JTAG

С увеличаване сложността на проектираните платки, инженерите започнали да слагат тестови точки на самата платка [5].

*По този начин по-голям брой сигнали е било възможно да се тестват.

*Тестовите точки се достъпвали със специално разработени за целта тестери, оборудвани с контактни игли (пого пинове).

Интерфейс JTAG



Интерфейс JTAG

Сложността на платките продължила да расте, и тестовите точки вече не били достатъчни за пълен тест.

Производителите на чипове решили да добавят т.нар. **гранична сканираща логика** (**Boundary Scan Logic, BSL**), която се използва за четене на входни и изходни точки на интегралната схема.

Ядрото на BSL са **граничните сканиращи клетки** (**Boundary Scan Cell, BSC**), които представляват еднобитови преместващи регистри, свързани на входовете и изходите на ИС. Тези регистри са свързани последователно и формират един многоразреден преместващ регистър, който може да бъде записван и четен.

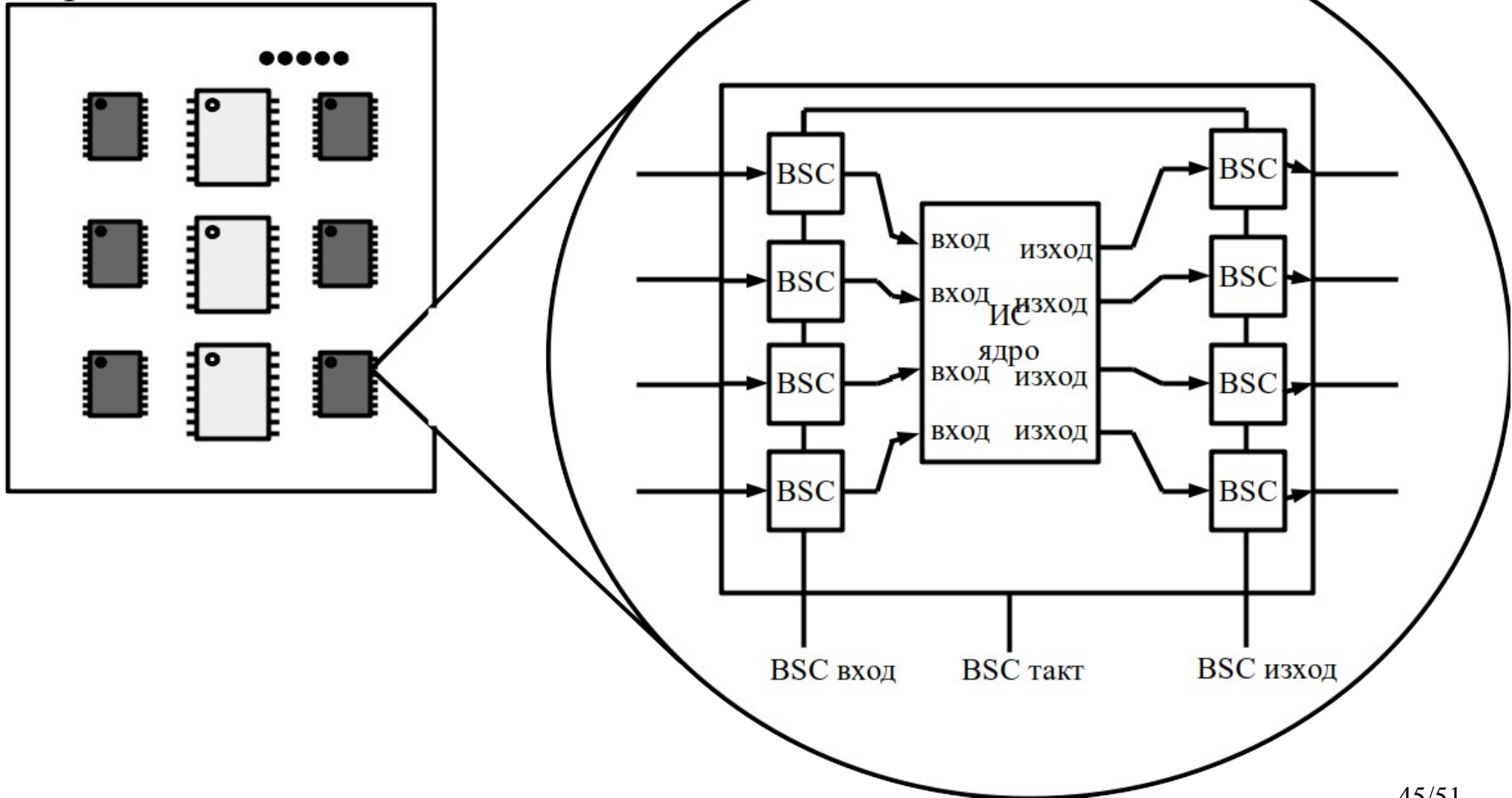
Интерфейс JTAG

Данните в BSC се записват/четат под управлението на **тактов сигнал**.

Понеже **образуваният регистър е сериен**, то и изводите, необходими за достъпа му са **малко на брой**. Оттук идва драстичното намаляване на тестовите точки върху самата платка.

Интерфейс JTAG

Разработвана система



Интерфейс JTAG

Към BSC трябва да се добави управляваща логика:

***TAP контролер** (Test Access Port) – машина на състоянието, която контролира цялата вътрешна BSL, така че дадена тестова операция да се изпълни.

TAP контролерът включва в себе си два вида регистри:

***Регистър на инструкцията** – 8-битов регистър, съдържащ число, което отговаря на:

- тестовата операция, която трябва да се изпълни;
- режим на работа на BSL
- регистри, които да бъдат включени в BSL веригата
- източници на данни за данновите регистри

Интерфейс JTAG

Даннови регистри – набор от регистри, специфични за всеки чип, но винаги съдържащи общите регистри BSR, BYPASS, IDCODES. Понякога към общите регистри се включва и BCR регистъра.

***BSR (Boundary Scan Register)** – преместващ регистър, изграден от всички BSC на чипа. Отразява настоящото състояние на входовете/изходите на чипа, както и осигурява възможността за промяната им от потребителя.

***BYPASS регистър** – използва се за съкращаване на BSR регистъра, когато е необходимо. Той просто свързва входа и изхода на BSR през един еднобитов преместващ регистър.

Интерфейс JTAG

IDCODES регистър – съдържа информация за чипа, като например име на производител, номер на чип, версия, и т.н [6].

BCR регистър (**B**oundary **C**ontrol **R**egister) – 2-битов регистър, използван за разрешаване на допълнителни тестови операции, показани в таблицата по-долу:

Table 3. Boundary-Control Register Opcodes

BINARY CODE BIT 1 → BIT 0 MSB → LSB	DESCRIPTION
00	Sample inputs/toggle outputs (TOPSIP)
01	Pseudo-random pattern generation / 16-bit mode (PRPG)
10	Parallel-signature analysis/16-bit mode (PSA)
11	Simultaneous PSA and PRPG/8-bit mode (PSA/PRPG)

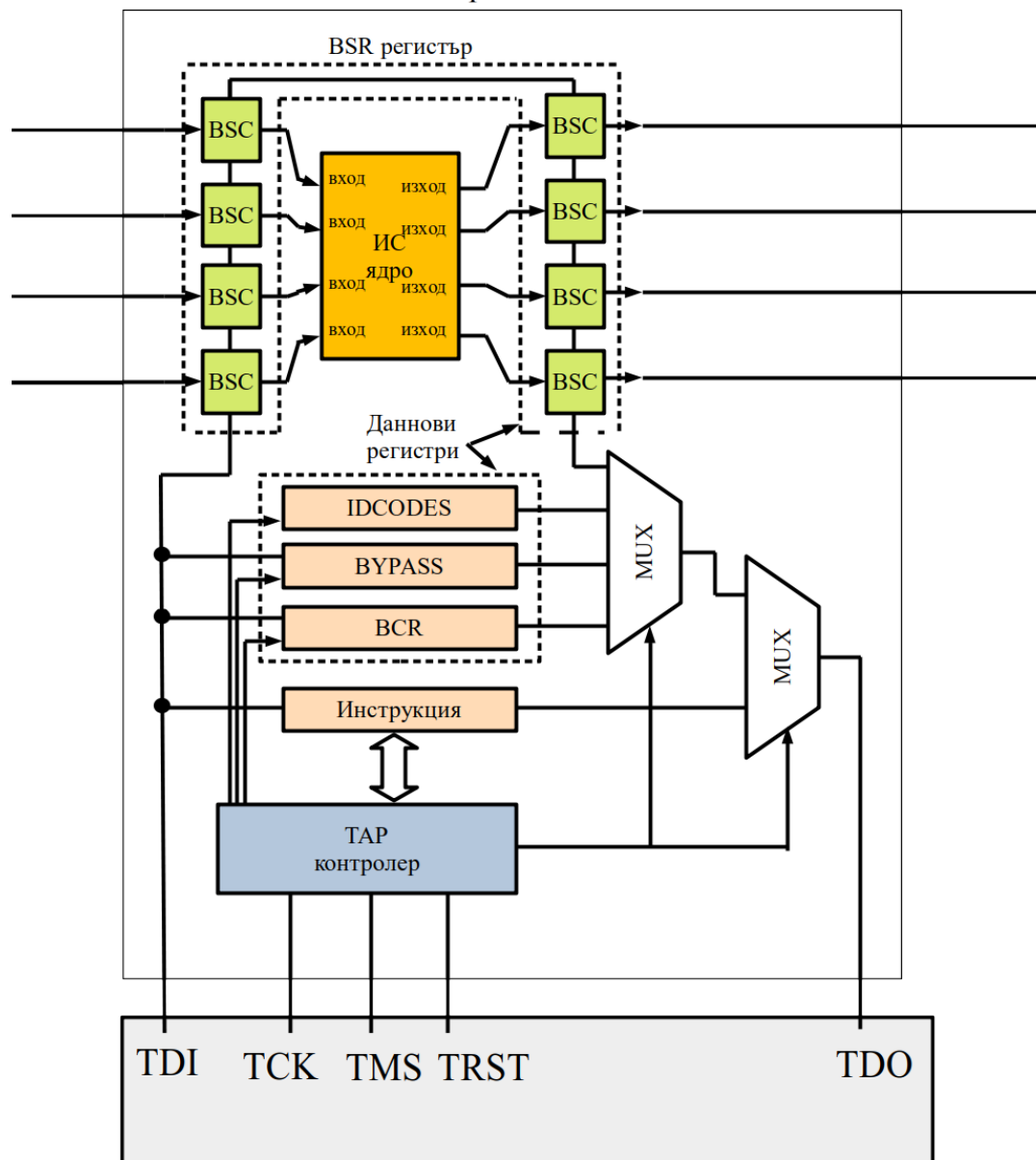
Интерфейс JTAG

JTAG интерфейс (Joint Test Action Group, IEEE 1149.1) – стандартизиран от индустрията интерфейс, използван от инженерите за тестване и програмиране на логически елементи (виж SN74VCT8244A), специализирани чипове (ASIC), програмируеми матрици (FPGA), микропроцесори (μ PU), микроконтролери (μ CU), цифрови сигнални процесори (DSP) и др.

JTAG е съвкупността от управляващи сигнали на TAP контролера и данновите сигнали на BSR регистъра.

Интерфейс JTAG

Интегрална схема



JTAG интерфейс

Литература

- [1] "NAND Flash 101: An Introduction to NAND Flash and How to Design It In Your Next Product", Technical Note TN-29-09, Micron, 2006.
- [2] "FRAM – New Generation of Non-Volatile Memory", SZZT014A, 2009.
- [3] M48Z02 Zeropower SRAM, Datasheet, ST Microelectronics, 2003.
- [4] MT29F4G08FABWP Datasheet, Micron, 2004.
- [5] Г. Михов, "Настройка и диагностика на микропроцесорни системи", ТУ-София, 2005.
- [6] "IEEE Standard 1149.1 (JTAG) in the SX/RTSX/SXA/eX/RT54SX-S Families", Application Note AC160, Microsemi, 2012.
- [7] "SN74BCT8244A Scan Test Devices with Octal Buffers", Datasheet, Texas Instruments, 1996.